

ФИО (полностью)	Марьяна Елена Владимировна		
Образование	Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»: специальность 14.03.06 «Электроника и автоматика физических установок», специалист, инженер-физик специальность 38.05.01 «Экономическая безопасность», специалист, экономист специальность 14.04.02 «Ядерная физика и технологии», магистр		
Направление подготовки	05.13.05 «Элементы и устройства вычислительной техники и систем управления»		
Отдел/отделение	Отдел тестирования микросхем ОРВС		
Форма обучения	Очная		
Период обучения	01.09.2018-31.08.2022		
Тема научно-квалификационной работы			
Научный руководитель (Ф.И.О. полностью, должность, ученая степень, ученое звание)	к.т.н., доцент, Краснюк Андрей Анатольевич		
Владение иностранными языками, в какой степени	Английский язык, уверенное владение		
Аттестация Ученым советом:			
Дата	Номер и дата протокола Ученого совета	Результаты прохождения аттестации (оценка)	
<b>Утверждение темы диссертации</b>	<b>Номер и дата протокола Ученого совета</b>	<b>Тема утверждена:</b> (название темы, утвержденной на Ученом совете)	
Промежуточная аттестация (за первый семестр)			
Годовая аттестация (за 1 год обучения)			
Промежуточная аттестация (за третий семестр)			
Годовая аттестация (за 2 год обучения)			
Промежуточная аттестация (за пятый семестр)			
Годовая аттестация (за 3 год обучения)			
Промежуточная аттестация (за седьмой семестр)			
Годовая аттестация (за 4 год обучения)			
<b>Сдача кандидатских экзаменов:</b>	<b>Дата (год)</b>	<b>Оценка</b>	
История и философия науки			
Иностранный язык			
Специальность			
<b>Сдача дисциплин Учебного плана</b>	<b>Дата (год)</b>	<b>Оценка</b>	
Б1.В.ОД Обязательные дисциплины:			
Педагогика и психология высшей школы			
Методология научного исследования			
Информационные средства научных исследований на супер ЭВМ			
Дисциплины по выбору:			
<b>Педагогическая практика:</b>			
Место прохождения	Количество часов, в т.ч. аудиторных	Результаты прохождения	

НИЯУ МИФИ					
<b>Научно-исследовательская практика:</b>					
<b>Место прохождения</b>		<b>Количество часов, в т.ч. аудиторных</b>		<b>Результаты прохождения</b>	
<b>Публикации (патенты) по теме исследования:</b>					
№ п/п	Наименование работы, ее вид	Выходные данные	Объем п.л	Соавторы	Рецензия
1	Моделирование субмикронного PDCFET транзистора (тезисы доклада на конференции)	XVII Международная телекоммуникационная конференция молодых ученых и студентов. "Молодежь и наука 2014" С. 105-106.	2 стр.	Имаметдинов Э.Ф.	
2	Разработка и моделирование субмикронных PDCFET транзисторов (статья)	Проблемы разработки перспективных микро- и нанoeлектронных систем (МЭС). 2014. № 2. С. 155-158.	3 стр.	Краснюк А.А., Орлов О.М., Имаметдинов Э.Ф.	
3	Моделирование транзисторных МДП-структур для предельных режимов работы (тезисы доклада на конференции)	XVIII Международная телекоммуникационная конференция молодых ученых и студентов. "Молодежь и наука 2015" С. 137-138.	2 стр.	Имаметдинов Э.Ф.	
4	Анализ характеристик субмикронных МДП-транзисторов с периодическим легированием канала для предельных температурных режимов работы (статья)	Микроэлектроника. 2015. Т. 44. № 4. С. 263-269.	6 стр.	Краснюк А.А., Орлов О.М., Имаметдинов Э.Ф.	
5	Analysis of characteristics for periodically doped channel field-effect transistors under extreme thermal conditions (статья)	Russian Microelectronics. 2015. Т. 44. № 4. С. 231-235.	4 стр.	Краснюк А.А., Орлов О.М., Имаметдинов Э.Ф.	
6	Адаптация топологического размещения элементов микросхемы при переходе к 28 нм технологическим нормам (тезисы доклада на конференции)	XIX Международная телекоммуникационная конференция студентов и молодых ученых "Молодежь и наука 2016" С. 179-180.	2 стр.		
7	Исследование термостабильности МОП-транзистора с периодически легированным	XIX Международная телекоммуникационная конференция студентов	2 стр.	Имаметдинов Э.Ф.	